



现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流
- ▶ 科研项目资金管理

美国马萨诸塞大学J. Joshua Yang教授来微电子所访问交流

2016-09-12 | 编辑: 微电子重点实验室 张康玮 | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

9月6日, 美国马萨诸塞大学J. Joshua Yang教授来微电子所进行学术交流, 并作了题为“Challenges and solutions for memristors used for memory and neuromorphic computing”的学术报告。微电子所刘明院士主持交流会, 全所科研人员、研究生共40余人参加了交流会。

Yang在报告中介绍了采用选择器的非线性电流电压特性来解决忆阻器交叉阵列结构中的串扰问题以及神经形态计算等。其制备的超过 10^{10} 非线性电流电压特性的选择器已应用在基于忆阻器的交叉阵列结构中。鉴于在神经形态计算中, Ca^{2+} 的积累和扩散对生物突触的变化有重要作用, 他开发了在功能氧化物中掺杂Ag的忆阻器, 在电子设备中模仿这个基本突触动态过程。该忆阻器及其动力学可以直接模拟生物神经突触动态过程。Yang同与会人员就新型存储器及其应用等领域进行了交流。

J. Joshua Yang现任美国马萨诸塞大学电子与计算机工程系教授, 研究兴趣是纳电子学和纳离子学及在能源和计算中的应用, 先后发表学术期刊论文100余篇。



交流会现场



附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029
单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn
京公网安备110402500036号

